

H 01 L

Ans.nr.: 1583/83

Indleveret: 11 apr 1983

Løbedag: 11 apr 1983

Alm. tilgængelig: 16 okt 1983

Prioritet: 15 apr 1982 IT 67501/82

*CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.; Torino, IT.

Opfinder: Marco *Gandini; IT, Dante *Trevisan;
IT.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Grundcelle til portrækker i integrerede kredsløb

SAMMENDRAG

1583-83

Cellen består af fire transistorer (T1, T2, T3, T4). To af dem (T2, T3) ligger symmetrisk med hensyn til central cellepunkt, og deres porteledninger (C, C') er indbyrdes forbundne af en polysiliciumpassage (1), der går hen over de spændingsførende metalledninger (Vss, Vdd). En anden polysiliciumpassage (2) forbinder området, der ligger på hver sin side af en zone, der afgrænses af de spændingsførende ledninger. Kontakterne (A, B, C, C', D, D', E, E', G, G', H, H', I, I') til transistorerledningerne er anbragt således, at celleoverfladen bliver mindst mulig.

Denne grundcelle kan anvendes til realisering af mange forskellige kredsløbsfunktioner. Fremstillingen billiggøres ved, at der kun kræves specialmasker til det sidste metalliserings-trin.

1583-83

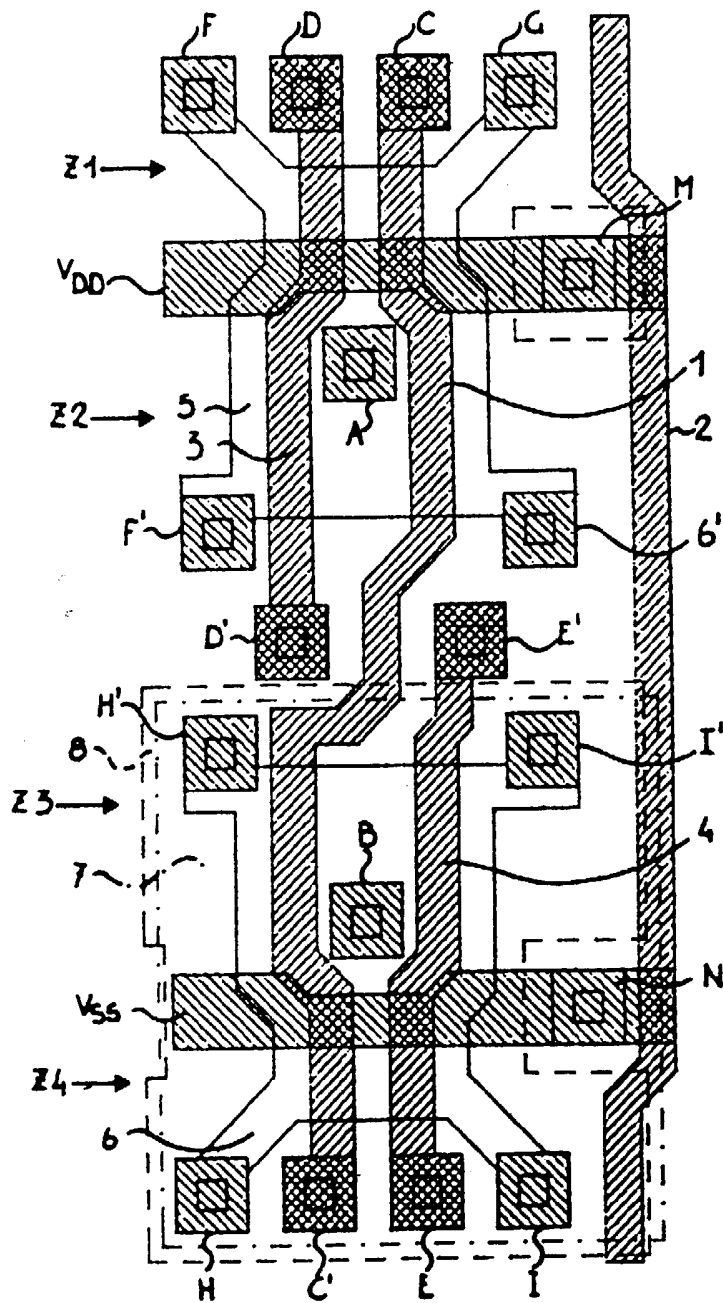


Fig. 2